

電磁気学復習ノート

山影 相

2017年7月21日

概要

一度、電磁気を学んだ読者を想定している。

目次

1	ベクトル解析	2
2	多極子展開	3
3	静電場	4
3.1	ガウスの法則	4
3.2	電気分極と誘導電荷	6
3.3	クラウジウス・モソッティの関係式	8
4	コンデンサ	11
4.1	平行平板コンデンサ	11
4.2	同心球コンデンサ	11
5	静磁場	12
5.1	直線電流がつくる磁場	12
5.2	円筒電流	13
5.3	磁気双極子	14
5.4	トルク	15
5.5	インダクタンス	16
6	電磁場	17

6.1	マクスウェルの応力	18
6.2	電磁波	19

1 ベクトル解析

以下にベクトル解析の公式をリストする.

球座標 :

$$\mathbf{e}_r = e_x \sin \theta \cos \phi + e_y \sin \theta \sin \phi + e_z \cos \theta, \quad (1)$$

$$\mathbf{e}_\theta = e_x \cos \theta \cos \phi + e_y \cos \theta \sin \phi - e_z \sin \theta, \quad (2)$$

$$\mathbf{e}_\phi = -e_x \sin \phi + e_y \cos \phi, \quad (3)$$

$$\mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_\theta = \mathbf{e}_\phi, \quad \mathbf{e}_\theta \times \mathbf{e}_\phi = \mathbf{e}_r, \quad \mathbf{e}_\phi \times \mathbf{e}_r = \mathbf{e}_\theta, \quad (4)$$

$$\frac{\partial \mathbf{e}_r}{\partial \theta} = \mathbf{e}_\theta, \quad \frac{\partial \mathbf{e}_r}{\partial \phi} = \mathbf{e}_\phi \sin \theta, \quad (5)$$

$$\frac{\partial \mathbf{e}_\theta}{\partial \theta} = -\mathbf{e}_r, \quad \frac{\partial \mathbf{e}_\theta}{\partial \phi} = \mathbf{e}_\phi \cos \theta, \quad (6)$$

$$\frac{\partial \mathbf{e}_\phi}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial \mathbf{e}_\phi}{\partial \phi} = -\mathbf{e}_r \sin \theta - \mathbf{e}_\theta \cos \theta, \quad (7)$$

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} = \mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}, \quad (8)$$

円筒座標 :

$$\mathbf{e}_\rho = e_x \cos \phi + e_y \sin \phi, \quad (9)$$

$$\mathbf{e}_\phi = -e_x \sin \phi + e_y \cos \phi, \quad (10)$$

$$\mathbf{e}_z = e_z, \quad (11)$$

$$\mathbf{e}_\rho \times \mathbf{e}_\phi = \mathbf{e}_z, \quad \mathbf{e}_\phi \times \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_\rho, \quad \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_\rho = \mathbf{e}_\phi, \quad (12)$$

$$\frac{\partial \mathbf{e}_\rho}{\partial \phi} = \mathbf{e}_\phi, \quad \frac{\partial \mathbf{e}_\phi}{\partial \phi} = -\mathbf{e}_\rho, \quad (13)$$

$$\nabla = \mathbf{e}_\rho \frac{\partial}{\partial \rho} + \mathbf{e}_\phi \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}, \quad (14)$$

点電荷:

$$\Delta \frac{1}{r} = \nabla \cdot \nabla \frac{1}{r} = -4\pi \delta^3(\mathbf{r}). \quad (15)$$

曲面 $\mathbf{d}(u, v)$ の微小面積要素:

$$d\mathbf{S} = dudv \frac{\partial \mathbf{d}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{d}}{\partial v}. \quad (16)$$

例として、球面の面積を上式より求める。球面は2つのパラメタ $\theta \in [0, \pi]$, $\phi \in [0, 2\pi]$ を用いて $d_x = a \sin \theta \cos \phi$, $d_y = a \sin \theta \sin \phi$, $d_z = a \cos \theta$ と表示できるので、球面の面積は

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \left| \frac{\partial \mathbf{d}}{\partial \theta} \times \frac{\partial \mathbf{d}}{\partial \phi} \right| = 4\pi a^2. \quad (17)$$

なお、 $d\mathbf{S}$ は向きがあるので、 $\mathbf{d}(u, v)$ が u と v に関して単調な関数であれば簡単であるが、そうでない場合は注意が必要である。

2 多極子展開

原点に点電荷 q が置かれている場合の静電ポテンシャル $\phi_0(\mathbf{r})$ は

$$\phi_0(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon r}, \quad (18)$$

であるが、実際には厳密に“点”ということではなく、適当な電荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ で表されるのが普通である。この電荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ がつくる静電ポテンシャルは

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (19)$$

となる。勿論、 $\rho(\mathbf{r}) = q\delta^3(\mathbf{r})$ とすれば式(18)が再現される。

さて、しばしば、電荷はある有限の領域 Ω 内だけに分布しており $[\rho(\mathbf{r} \notin \Omega) = 0]$ 、それが十分遠方 ($r \rightarrow \infty$) につくる静電ポテンシャルが問題になる。例えば、物質に電場を印加する、といった状況である。こうした場合には $r > r'$ として式(19)の被積分関数を $1/r$ に関して冪展開することが許される。その結果は

$$\phi(\mathbf{r}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4\pi\epsilon r^{n+1}} \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') r'^n P_n(\cos \theta_{\mathbf{r}\mathbf{r}'}), \quad (20)$$

である。 $\theta_{\mathbf{r}\mathbf{r}'}$ は \mathbf{r} と \mathbf{r}' のなす角であり、 P_n はルジャンドル多項式である。低次のものを具体的に書き下すと

$$P_0(x) = 1, P_1(x) = x, P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}, P_3(x) = \frac{5x^3 - 3x}{2}, \quad (21)$$

であり、それぞれ対応する静電ポテンシャル $\phi_0(\mathbf{r}), \phi_1(\mathbf{r}), \phi_2(\mathbf{r}), \phi_3(\mathbf{r})$ は

$$\phi_0(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon r}, \quad q = \int d^3r \rho(\mathbf{r}), \quad (22)$$

$$\phi_1(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{4\pi\epsilon r^3}, \quad \mathbf{p} = \int d^3r \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}), \quad (23)$$

$$\phi_2(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{3}{2} \frac{x_i x_j q_{ij}}{r^5}, \quad q_{ij} = \int d^3r \left(x_i x_j - \frac{r^2}{3} \delta_{ij} \right) \rho(\mathbf{r}), \quad (24)$$

$$\phi_3(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{x_i x_j x_k o_{ijk}}{r^7}, \quad (25)$$

$$o_{ijk} = \int d^3r \left(\frac{5}{2} x_i x_j x_k - \frac{r^2}{2} x_i \delta_{jk} - \frac{r^2}{2} x_j \delta_{ki} - \frac{r^2}{2} x_k \delta_{ij} \right) \rho(\mathbf{r}), \quad (26)$$

と与えられる。この形から明らかなように、 ϕ_0 は点電荷 q 、 ϕ_1 は双極子モーメント \mathbf{p} 、 ϕ_2 は四極子モーメント q_{ij} 、 ϕ_3 は八極子モーメント o_{ijk} がつくるポテンシャルになっていることが分かる。これらの多極子モーメントは系の対称性により多くの成分が零になる。例えば電荷分布が空間反転対称性を有している場合、 $\rho(\mathbf{r}) = \rho(-\mathbf{r})$ 、には全ての奇数次のモーメントが零になる。

3 静電場

この節では $\epsilon_0 = 1$ とおく。

3.1 ガウスの法則

電荷分布 $\rho_{\text{ex}}(\mathbf{r})$ が与えられたとする。“与えられた”の意は、電荷分布 $\rho_{\text{ex}}(\mathbf{r})$ は何らかの方法で固定されており、電場を印加しても変化しない、ということである。そのような電荷分布が誘起する静電場 $\mathbf{E}_{\text{ex}}(\mathbf{r})$ を決定するガウスの法則は

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_{\text{ex}}(\mathbf{r}) = \rho_{\text{ex}}(\mathbf{r}), \quad (27)$$

と微分形で表される。これはマクスウェル方程式の第1式である。その解は $\mathbf{E}_{\text{ex}}(\mathbf{r}) = -\nabla\phi_{\text{ex}}(\mathbf{r})$ であり、静電ポテンシャル $\phi_{\text{ex}}(\mathbf{r})$ は

$$\phi_{\text{ex}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{\rho_{\text{ex}}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (28)$$

である。

証明

静電場 \mathbf{E} はポテンシャル ϕ により、 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ であるから、ガウスの法則は

$$\Delta\phi = -\rho, \quad (29)$$

というポアソン方程式を与える。その一般解は

$$\phi(\mathbf{r}) = \int d^3r' G(\mathbf{r} - \mathbf{r}')\rho(\mathbf{r}') + \phi_0(\mathbf{r}), \quad (30)$$

の形に与えられる。ここで G は $\Delta\phi(\mathbf{r}) = -\delta(\mathbf{r})$ を満たすグリーン関数であり、 ϕ_0 は調和関数、 $\Delta\phi_0 = 0$ 、である。無限遠方には電場は無いとすると、 $\phi_0 = 0$ である。

グリーン関数をフーリエ展開

$$G(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} G_{\mathbf{k}}, \quad (31)$$

により解こう。デルタ関数は

$$\delta(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \quad (32)$$

と表現できるので、グリーン関数は

$$G_{\mathbf{k}} = \frac{1}{k^2}, \quad (33)$$

である。

$$G(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{k^2} = \int_0^\infty \frac{dk}{2\pi} \int_0^\pi \frac{d\theta}{2\pi} \sin\theta e^{ikr\cos\theta} = \int_0^\infty \frac{dk}{2\pi} \frac{\sin(kr)}{\pi kr}. \quad (34)$$

積分公式

$$\int_0^\infty dx \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{2}, \quad (35)$$

を用いると、グリーン関数が

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi r}, \quad (36)$$

と求められる。結局、静電ポテンシャルは

$$\phi(\mathbf{r}) = \int d^3r' G(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') = \int \frac{d^3r'}{4\pi |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \rho(\mathbf{r}') \quad (37)$$

となることが分かる。

証明は以上で終わりであるが、幾つか性質を観察しておく。 $1/r$ の微分は直接計算できるので、

$$\nabla \frac{1}{r} = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}, \quad \Delta \frac{1}{r} = \nabla \cdot \nabla \frac{1}{r} = \frac{3\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}{r^5} - \frac{\nabla \cdot \mathbf{r}}{r^3} = 0, \quad (38)$$

となり、 $\Delta(1/r)$ が零のように見えるが、これは特異点 $r = 0$ を除いたときの話である。すなわち、上の計算は

$$\Delta \frac{1}{r} = 0 \text{ for } r \neq 0, \quad (39)$$

を意味している。さらに、これを半径 r の球で積分すると

$$\int d^3r \nabla \cdot \nabla \frac{1}{r} = \int dS \cdot \nabla \frac{1}{r} = - \int dS \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = -4\pi, \quad (40)$$

であり、有限値になる。これはすなわち、

$$\Delta \frac{1}{r} = -4\pi \delta^3(\mathbf{r}), \quad (41)$$

に他ならない。

証明終

3.2 電気分極と誘導電荷

次に電荷分布 $\rho_{\text{ex}}(\mathbf{r})$ の他に誘電体が存在する場合を考える。電荷分布 $\rho_{\text{ex}}(\mathbf{r})$ は変化しないが、それがつくる電場により、誘電体内の電荷分布は $\rho_{\text{in}}(\mathbf{r})$ だけ変化し、系全体の電荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ は

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_{\text{ex}}(\mathbf{r}) + \rho_{\text{in}}(\mathbf{r}), \quad (42)$$

となる。誘起された電荷分布 $\rho_{\text{in}}(\mathbf{r})$ はさらに電場を誘起するが、これを $-\mathbf{P}$ とし、系全体の電場 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ を

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_{\text{ex}}(\mathbf{r}) - \mathbf{P}(\mathbf{r}), \quad (43)$$

と表す。すなわち、 \mathbf{P} は電場に対する誘電体の応答であり、電気分極と呼ばれる。最終的な電場の分布はやはりガウスの法則を満たすから

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}), \quad \nabla \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}) = -\rho_{\text{in}}(\mathbf{r}), \quad (44)$$

が成立する。

一様な誘電体では誘導電荷 ρ_{in} はその表面のみに現れる。電気分極は誘電体の内部では \mathbf{P} という一定値をとり、外部では零である。すると、表面を除けば $\rho_{\text{in}}(\mathbf{r}) = -\nabla \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}) = 0$ である。 \mathbf{r} が表面 (平坦とする) 上にあるとし、その面の法線方向を x_{\perp} とすると $\mathbf{P}(\mathbf{r}) = P\theta(r_{\perp} - x_{\perp})$ であり、

$$\rho_{\text{in}}(\mathbf{r}) = -\frac{\partial P_{\perp}(\mathbf{r})}{\partial x_{\perp}} = P_{\perp}(\mathbf{r})\delta(r_{\perp} - x_{\perp}), \quad (45)$$

つまり、面密度 $\rho_{\text{in}}^{2D}(\mathbf{r}) = P_{\perp}(\mathbf{r})$ の電荷が表面に誘起される。

次に、電気分極 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ がつくる電場がどうなるかを考えよう。ガウスの法則 $\nabla \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}) = -\rho_{\text{in}}(\mathbf{r})$ により、静電ポテンシャル $\phi_{\text{in}}(\mathbf{r})$ は

$$\begin{aligned} \phi_{\text{in}}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{\rho_{\text{in}}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -\frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{\nabla \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}, \end{aligned} \quad (46)$$

と変形できる。一方、 \mathbf{r}' に位置する電気双極子 $\mathbf{p}(\mathbf{r}')$ がつくるポテンシャルは (23) 式より

$$\phi_{\text{dipole}}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi} \mathbf{p}(\mathbf{r}') \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}, \quad (47)$$

である。上の2式から、電気分極 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ は電気双極子の密度と解釈できる。すなわち、 \mathbf{r} の周りの微小領域に存在する電気双極子は $\mathbf{p}(\mathbf{r}) = \mathbf{P}(\mathbf{r})d^3r$ である。

ところで、電気双極子の定義を思い起こすと $\mathbf{p}(\mathbf{r}) = \mathbf{r}\rho(\mathbf{r})d^3r$ であるが、一様な誘電体では $\rho(\mathbf{r} \notin \partial\Omega) = 0$ であったから、 $\mathbf{p}(\mathbf{r} \notin \partial\Omega) = \mathbf{0}$ および $\mathbf{P}(\mathbf{r} \notin \partial\Omega) = \mathbf{0}$ となり、なにかおかしい、と思うかもしれない。実は、この議論においては巨視的・微視的といった2つのスケールを行き交っているために話が少し難しくなっている。誘電体は巨視的には、表面 $\partial\Omega$ を除けば、電荷中性 $\rho^{\text{macro}}(\mathbf{r} \notin \partial\Omega) = 0$ である。しかし、原子スケールで見れば原子軌道やイオンの分極が生じており、微視的な電荷分布は誘電体の内部でも有限 $\rho^{\text{micro}}(\mathbf{r} \in \Omega) \neq 0$ となっている。ただし、これを粗視化すると

$$\rho^{\text{macro}}(\mathbf{r}) = \int_{\mathbf{r}} \frac{d^3r'}{\Delta V} \rho^{\text{micro}}(\mathbf{r}') = 0, \quad (48)$$

でなければならない。ここで積分は \mathbf{r} の周りの体積 ΔV の適当な領域で行われる。結晶であれば、この粗視化を行う適当な領域は基本単位胞であろう。このとき、電気分極は

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \int_{\mathbf{r}} \frac{d^3 r'}{\Delta V} \mathbf{r}' \rho^{\text{micro}}(\mathbf{r}'), \quad (49)$$

のように、単位体積あたりの「微視的な」電気双極子として与えられるのである。このようにして、(巨視的な)電荷分布は零であるが(微視的な)電気双極子および(巨視的な)電気分極は有限、という状況を実現できる。

3.3 クラウジウス・モソッティの関係式

前節で導入した、誘電体の巨視的な応答を表す電気分極 \mathbf{P} は微視的な電荷分布が構成する電気双極子 \mathbf{p} を粗視化したものである、すなわち、 $\mathbf{P} = (\Delta V)^{-1} \int_{\Delta V} d^3 r \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) = \mathbf{p}/\Delta V$ 、という考え方は、誘電体の誘電率 ϵ を微視的に評価する方法を与える。例えば、球状の誘電体(結晶)の比誘電率 ϵ は、微視的な電気双極子 $\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}_{\text{local}}$ の分極率 α を用いて

$$\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} = \frac{1}{3} \frac{\alpha}{\Delta V}, \quad (50)$$

と評価できる。ここで $\mathbf{E}_{\text{local}}$ は微視的な(局所)電場である。これをクラウジウス・モソッティの関係式と呼ぶ。以下にその導出を示す。

半径 a の誘電体球が原点に存在しており、これに外部電場 $\mathbf{E}_0 = E_0 \mathbf{e}_z$ を印加し、誘電体内には一様に電気分極 $\mathbf{P} = P \mathbf{e}_z$ が生じたとする。まず、この系の巨視的な応答を議論し、電気分極と外部電場の関係を決める。次に微視的な電気双極子と外部電場の関係を議論し、最終的にこれらを繋ぐ(外部電場を消去する)ことでクラウジウス・モソッティ関係式が得られる、という流れである。

この系の静電ポテンシャル $\phi(\mathbf{r})$ は

$$\phi(\mathbf{r}) = \begin{cases} \phi_i(\mathbf{r}), & r < a, \\ \phi_o(\mathbf{r}), & r > a, \end{cases} \quad (51)$$

と2つの領域に分けられる。誘電体がつくる静電ポテンシャルは、十分に遠方においては電気双極子 $\mathbf{p} = 4\pi a^3 \mathbf{P}/3$ がつくるもの、 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}/(4\pi r^3)$ 、と同じであるから、外部電場と合わせて、

$$\phi_o(\mathbf{r})|_{r \gg a} \sim -E_0 r \cos \theta + \frac{p \cos \theta}{4\pi r^2} = -E_0 r \cos \theta + \frac{a^3}{3r^2} P \cos \theta, \quad (52)$$

である。一方、球座標におけるラプラス方程式の一般解のうち、軸対称 (φ 依存性が無い) のものは

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n r^n + \frac{B_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta), \quad (53)$$

という形なので、 $\phi_o(\mathbf{r})$ の一般形は

$$\phi_o(\mathbf{r}) = -E_0 r \cos \theta + \frac{a^3}{3r^2} P \cos \theta + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{B_n}{r^{n+1}} P_n(\cos \theta), \quad (54)$$

である。一方、球内では $r = 0$ で電場が有限であることから

$$\phi_i(\mathbf{r}) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta), \quad (55)$$

の形になる。

また、ポテンシャルおよび電束密度の連続性：

$$\phi_i(\mathbf{r})|_{r=a} = \phi_o(\mathbf{r})|_{r=a}, \quad \epsilon \frac{\partial \phi_i(\mathbf{r})}{\partial r} \Big|_{r=a} = \frac{\partial \phi_o(\mathbf{r})}{\partial r} \Big|_{r=a} \quad (56)$$

(ϵ は誘電率) を課すことにより、

$$A_0 = 0, \quad A_1 = -E_0 + \frac{P}{3}, \quad a^{2n+1} A_n = B_n, \quad (57)$$

$$A_1 = -\frac{1}{\epsilon} \left(E_0 + \frac{2}{3} P \right), \quad \epsilon n a^{2n+1} A_n = (-n-1) B_n, \quad (58)$$

を得る。すなわち、 $A_0 = 0$ 、および $n \geq 2$ に対して $A_n = B_n = 0$ である。さらに、 A_1 に対しては2つの関係式が課されている。これらより、

$$P = 3 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} E_0, \quad (59)$$

でなければならない。以上より、球内の静電ポテンシャルは

$$\phi_i(\mathbf{r}) = - \left(E_0 - \frac{P}{3} \right) r \cos \theta, \quad (60)$$

と求められる。したがって球内には

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 - \frac{\mathbf{P}}{3}, \quad (61)$$

という一様電場が生じる。(59)・(61)式が誘電体の巨視的応答を記述している。

次に微視的な応答である電気双極子を考察する． \mathbf{r}_j に位置する電気双極子 \mathbf{p} がつくる電場は

$$-\nabla \frac{\mathbf{p} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_j)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_j|^3} = \frac{3\mathbf{p} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_j)(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j) - \mathbf{p}|\mathbf{r} - \mathbf{r}_j|^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_j|^5}, \quad (62)$$

である．結晶ではこの電気双極子が多数個並んでいる．周期性から，全ての電気双極子は同じ値をもつ．以下では最も簡単な例として立方晶を考え，立方対称位置に電気双極子があるとす．これらの電気双極子が，ある立方対称点 ($\mathbf{r} = \mathbf{0}$ と定める) につくる電場 \mathbf{E}_3 の第 μ 成分は

$$E_3^\mu = \sum_j \frac{3p^\nu r_j^\nu r_j^\mu - \mathbf{p}r_j^2}{r_j^5}. \quad (63)$$

立方対称点は反転中心でもあるから，奇数次の項は消える：

$$\sum_j \frac{r_j^\nu}{r_j^5} = 0. \quad (64)$$

また， x, y, z は等価であるから，

$$\sum_j \frac{(r_j^\mu)^2}{r_j^5} = \sum_j \frac{1}{3r_j^3}. \quad (65)$$

したがって $\mathbf{E}_3 = \mathbf{0}$ でなければならない．これは，立方対称点での微視的な局所電場 $\mathbf{E}_{\text{local}}$ が

$$\mathbf{E}_{\text{local}} = \mathbf{E}_0, \quad (66)$$

と外部電場に一致することを意味する．これを用いると，

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 - \frac{\mathbf{P}}{3} = \mathbf{E}_{\text{local}} - \frac{\mathbf{P}}{3}. \quad (67)$$

$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} = \mathbf{E} + \mathbf{P}$ より， $\mathbf{P} = (\epsilon - 1)\mathbf{E}$ なので，

$$\mathbf{E}_{\text{local}} = \frac{\epsilon + 2}{3} \mathbf{E}, \quad (68)$$

という，微視的と巨視的を繋ぐ関係式を得る．

さて，電気分極 \mathbf{P} は微視的な双極子を粗視化したものであったから，

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{p}}{\Delta V} = \frac{\alpha \mathbf{E}_{\text{local}}}{\Delta V}, \quad (69)$$

である．ここで分極率 α を導入した． ΔV は粗視化を行う領域の体積であり，例えば結晶の単位胞であろう．以上より，

$$\mathbf{E}_{\text{local}} = \frac{\epsilon + 2}{3} \mathbf{E} = \frac{\epsilon + 2}{3} \left(\mathbf{E}_{\text{local}} - \frac{\alpha}{3\Delta V} \mathbf{E}_{\text{local}} \right), \quad (70)$$

であり，これを解くとクラウジウス・モソッティ関係式

$$\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} = \frac{1}{3} \frac{\alpha}{\Delta V}, \quad (71)$$

を得る．分極率 α は微視的な理論から定量的に評価することができる．例えば，量子力学により，原子軌道に分極率を計算することができる（この他にもイオンの分極など，電気双極子の要因は様々である）．分極率が分かればクラウジウス・モソッティ関係式を援用することにより，巨視的な誘電体の誘電率を決めることができる．

4 コンデンサ

2つの金属板からなる系をコンデンサと呼ぶ．片方の金属板に電荷 Q ，もう片方に $-Q$ の電荷が蓄積したとき，金属板間には電圧 V が $Q = CV$ と生じる．この比例係数 C は静電容量と呼ばれ，金属板間の物質の誘電率やコンデンサの形状に依存する．

4.1 平行平板コンデンサ

最も簡単なコンデンサは面積 S の平板が距離 d だけ隔てられて平行に置かれた平行平板コンデンサである．平板は十分に大きく端の効果は無視できるものとする．このコンデンサの静電容量 C を求める．そのために，まず，平板1枚だけが存在し，これが電荷 Q に帯電しているときに周りにつくる電場 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ を求める．対称性から $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \text{sgn}(Qz)E_0\mathbf{e}_z$ である． E_0 はガウスの法則から $E_0 = Q/(2\epsilon)$ と決まる．平行平板間の電圧 V は平板間の電場と距離 d の積であるから，静電容量 $C = Q/V$ は

$$C = \frac{\epsilon S}{d}, \quad (72)$$

である．

4.2 同心球コンデンサ

半径 a と b , $a < b$, の同心球面からなるコンデンサを考える．対称性から，電場は動径 r 方向成分のみをもち， r のみに依存する： $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r)\mathbf{e}_r$ ．コンデンサ内 ($a < r < b$)

での電場の大きさは、内側の金属板の電荷を Q として、

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}, \quad (73)$$

である。したがって、コンデンサの電圧は

$$V = \int_a^b dr E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{b-a}{ab}, \quad (74)$$

で与えられることになる。すなわち、静電容量は

$$C = 4\pi\epsilon \frac{ab}{b-a}, \quad (75)$$

である、コンデンサ内の電場は

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{ab}{b-a} \frac{V}{r^2} \mathbf{e}_r. \quad (76)$$

5 静磁場

静磁場の源は電流である。電流 \mathbf{j} があるとその周りに磁場 \mathbf{H} が

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}, \quad (77)$$

に従って生じる。

∇ と \mathbf{j} はベクトルであるから、 \mathbf{H} は軸性ベクトル（擬ベクトル）でなければならない、すなわち空間反転に対して

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) \rightarrow -\mathbf{j}(-\mathbf{r}), \quad \mathbf{H}(\mathbf{r}) \rightarrow +\mathbf{H}(-\mathbf{r}), \quad (78)$$

と変換される。一方、時間反転に対しては

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) \rightarrow -\mathbf{j}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{H}(\mathbf{r}) \rightarrow -\mathbf{H}(\mathbf{r}), \quad (79)$$

とどちらも逆向きになる。

5.1 直線電流がつくる磁場

電流 I が z 軸上を流れているとする。電流密度としては $\mathbf{j} = I\delta(x)\delta(y)\mathbf{e}_z$ と書ける。それがつくる磁場 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ を求める。円筒座標が便利である。 $\mathbf{H}(\mathbf{r}) = H_\rho\mathbf{e}_\rho + H_\phi\mathbf{e}_\phi + H_z\mathbf{e}_z$.

まず、 z 方向の並進対称性から、磁場は z には依存しない。さらに、 z 軸周りの回転対称性から H_ρ, H_ϕ, H_z は動径成分 ρ のみに依存する*¹。また、 z 軸を含む鏡映に対して、電流は不変であるが、磁場（軸性ベクトル）の鏡映面内の成分は反転するから、磁場は鏡映面の面直成分しか持たない。これはすなわち、直線電流が誘起する磁場は

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = H_\phi(\rho)\mathbf{e}_\phi, \quad (80)$$

となることを意味する。すると、 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}$ を半径 ρ の円内 D で面積分することにより、

$$I = \iint_D d\mathbf{S} \cdot \nabla \times \mathbf{H}(\mathbf{r}) = H_\phi(\rho) \int_{\partial D} d\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_\phi = 2\pi\rho H_\phi(\rho), \quad (81)$$

ゆえに

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{I}{2\pi\rho}\mathbf{e}_\phi, \quad (82)$$

である。

5.2 円筒電流

今度は電流が半径 a の円筒上を流れているとしよう。

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = j^{2D}\delta(\rho - a)\mathbf{e}_\phi, \quad (83)$$

ここで j^{2D} は電流面密度であり [電流/長さ] の次元をもつ。同様に、軸周りの回転対称性から、 H_ρ, H_ϕ, H_z は ρ のみに依存する。今度は xy 面に関する鏡映に対して系は不変である。並進対称性と鏡映対称性により、磁場は z 成分しかもたないことが分かる。 $\mathbf{H}(\mathbf{r}) = H_z(\rho)\mathbf{e}_z$ 。 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}$ を $z\rho$ 面で積分する。円筒を横切らない面 $[(\rho, \phi, z), (\rho, \phi, z + \delta z), (\rho + \delta\rho, \phi, z + \delta z), (\rho + \delta\rho, \phi, z)]$ で囲まれる面で積分すると、ストークスの定理から

$$H_z(\rho)\delta z - H_z(\rho + \delta\rho)\delta z = 0, \quad (84)$$

であり、磁場は ρ には依存しない。また、円筒を横切る面、 $\rho < a, \rho + \delta\rho > a$, で積分すると、

$$H_z(\rho < a)\delta z - H_z(\rho > a)\delta z = j^{2D}\delta z, \quad (85)$$

*¹ 形式的に書くと、 R を回転行列として $\mathbf{H}(\mathbf{r}) = R\mathbf{H}(R^{-1}\mathbf{r})$ である。さらに、基底ベクトル $\mathbf{e}_\rho, \mathbf{e}_\phi, \mathbf{e}_z$ はこの変換に対して不変である。

であり、円筒の内と外で、磁場が j^{2D} だけ異なる。一方、円筒電流の総和は零、 $\int d^3r \mathbf{j} = \mathbf{0}$ 、であるから、無限遠方では磁場は零になる。以上より、円筒電流 $\mathbf{j}(\mathbf{r}) = j^{2D} \delta(\rho - a) \mathbf{e}_\phi$ がつくる磁場は

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = j^{2D} \theta(a - \rho) \mathbf{e}_z. \quad (86)$$

5.3 磁気双極子

もう少し複雑な電流分布が誘起する磁場を考察するために、ここで磁気双極子を導入する。 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}$ をベクトルポテンシャル $\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A}$ を用いて変形すると、クーロンゲージ $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ において

$$\Delta \mathbf{A} = -\mathbf{j}, \quad (87)$$

を得る。これはポアソン方程式であるから、その解として

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (88)$$

とベクトルポテンシャルが求められる。なお、定常状態における電荷保存則 $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ より、上式は確かにクーロンゲージ $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ になっている。

さて、上式に表されたベクトルポテンシャルは静電ポテンシャル (20) の時と同様に多極子展開ができる。展開の初項 (単極子) は恒等的に零である。

$$\mathbf{A}_0(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi r} \int d^3r' \mathbf{j}(\mathbf{r}') = \mathbf{0}. \quad (89)$$

これは、電荷保存則 $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ より導かれる $j_i = \nabla \cdot (x_i \mathbf{j})$ 、及び、ある有限の領域より外側では電流は無いことを用いて

$$\int d^3r' j_i(\mathbf{r}') = \int d^3r' \nabla' \cdot [x'_i \mathbf{j}(\mathbf{r}')] = \int d\mathbf{S} \cdot x_i \mathbf{j}(\mathbf{r}') = 0, \quad (90)$$

より示される。

次の項 (双極子) は

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi r^3} \int d^3r' \mathbf{j}(\mathbf{r}') (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'), \quad (91)$$

であるが、先程と同様の関係式： $\nabla' \cdot [x'_i \mathbf{j}(\mathbf{r}') (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}')] = j_i(\mathbf{r}') (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}') + x'_i \mathbf{j}(\mathbf{r}') \cdot \mathbf{r}$ より、

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi r^3} \int d^3r' [\mathbf{j}(\mathbf{r}') \cdot \mathbf{r}] \mathbf{r}', \quad (92)$$

であるから、これらを平均した

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi r^3} \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') [\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'] - [\mathbf{j}(\mathbf{r}') \cdot \mathbf{r}] \mathbf{r}'}{2}, \quad (93)$$

という表現を考えても良い。これはあからさまに $\nabla \cdot \mathbf{A}_1 = 0$ を満たしており、都合が良い。さらに、

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{4\pi r^3}, \quad \mathbf{m} = \frac{1}{2} \int d^3 r \mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r}), \quad (94)$$

と表すことが出来る。 \mathbf{m} は磁気双極子と呼ばれる。

5.3.1 円電流

例として、半径 a の円電流がつくる磁気モーメントを求める。円電流は $z = 0$ 面を正の向きに周回しているとする。すなわち、円筒座標系において

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = I \mathbf{e}_\phi \delta(\rho - a) \delta(z), \quad (95)$$

と表せる。系は xy 面に関する鏡映対称性をもつので、軸性ベクトルである磁気モーメントは z 成分のみをもつ。 $\mathbf{r} = \rho \mathbf{e}_\rho + z \mathbf{e}_z$ に注意して、

$$m_z = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} dz \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\infty} d\rho \rho^2 I \delta(\rho - a) \delta(z) = \pi a^2 I. \quad (96)$$

5.4 トルク

まず、トルクの力学について振り返っておく。トルクは

$$\mathbf{T} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}, \quad (97)$$

と定義される。これは角運動量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ の時間変化を与える。

$$\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{T}. \quad (98)$$

また、系に微小回転 $d\boldsymbol{\theta}$ を与えると、そのエネルギー変化は

$$dU = -d\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{r} \cdot \mathbf{F} = -d\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{T}, \quad (99)$$

というように、トルクで与えられる。

さて、電流分布のローレンツ力について考察する。その力密度 $\mathbf{f}(\mathbf{r})$ は

$$\mathbf{f}(\mathbf{r}) = \mathbf{j}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}), \quad (100)$$

であり，トルク密度は

$$\boldsymbol{\tau}(\mathbf{r}) = \mathbf{r} \times \mathbf{f}(\mathbf{r}) = \mathbf{r} \times [\mathbf{j}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r})] = (\mathbf{r} \cdot \mathbf{B})\mathbf{j} - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{j})\mathbf{B}. \quad (101)$$

例として，半径 a の円電流が磁場から受けるトルクを求める．電流密度は

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = I\delta\left(\sqrt{x^2 + y^2} - a\right)\delta(z)(-\sin\phi\mathbf{e}_x + \cos\phi\mathbf{e}_y), \quad (102)$$

である． $\mathbf{r} \cdot \mathbf{j} = 0$ より，

$$\begin{aligned} \mathbf{T} &= \int d^3r \boldsymbol{\tau} = \int d^3r (\mathbf{r} \cdot \mathbf{B})\mathbf{j} \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi a^2 (\cos\phi B_x + \sin\phi B_y) I (-\sin\phi\mathbf{e}_x + \cos\phi\mathbf{e}_y) \\ &= \pi a^2 I \mathbf{e}_z \times \mathbf{B}, \end{aligned} \quad (103)$$

と計算される．ここで (96) 式より，上式は磁気モーメントを用いて

$$\mathbf{T} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}, \quad (104)$$

と表現できる．

5.5 インダクタンス

多数個のコイル $1, 2, \dots$ からなる系を考える． i 番目のコイルに流れている電流を I_i ，コイルを貫いている磁束を Φ_i とすると，これらの間に

$$\Phi_i = L_{ij} I_j, \quad (105)$$

が成り立つ．係数行列 L はインダクタンスと呼ばれ，ビオ・サバールの法則から次のように求められる． Φ_i は

$$\Phi_i = \int_{S_i} d\mathbf{S} \cdot \mathbf{B} = \int_{\partial S_i} d\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}, \quad (106)$$

であり，ビオ・サバールの法則

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3x' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_i \frac{\mu_0 I_i}{4\pi} \int_{\partial S_i} \frac{d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (107)$$

を代入すると

$$\Phi_i = \frac{\mu_0 I_j}{4\pi} \int_{\partial S_i} \int_{\partial S_j} \frac{d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (108)$$

すなわち,

$$L_{ij} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\partial S_i} \int_{\partial S_j} \frac{d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (109)$$

と求められる. この式は i と j の入れ替えに対して対称であり, $L = L^T$ であることが分かる (相反定理).

また, 電磁誘導によりコイル i に

$$V_i = -L_{ij} \dot{I}_j, \quad (110)$$

だけの誘導起電力が生じる.

このコイル系のエネルギーを求めよう. 磁場を積分する代わりに, RL 回路を考えることによってコイルのエネルギーを導くことが出来る. 各々のコイルが, 独立に, RL 回路を構成 (抵抗は全て R) しており, 時刻 $t = 0$ に電流 I_i が流れていたとする. 時刻が経過すると電流は減衰し, その分のエネルギーがジュール熱として散逸するが, これは電流 $\mathbf{I} = (I_1, I_2, \dots)^T$ が流れていたコイルのエネルギーに等しい. それでは, RL 回路の電流の時間発展を求める. 時間発展方程式は

$$R\mathbf{I} = \mathbf{V}, \quad (111)$$

であり, その解は

$$\mathbf{I}(t) = \exp(-RL^{-1}t)\mathbf{I}, \quad (112)$$

という指数減衰である*2. ジュール熱の総和は, $L = L^T$ に注意して,

$$U = \int_0^\infty dt R\mathbf{I}(t)^T \mathbf{I}(t) = \int_0^\infty dt R\mathbf{I}^T \exp(-2RL^{-1}t) \mathbf{I} = \frac{1}{2} \mathbf{I}^T L \mathbf{I}. \quad (113)$$

6 電磁場

ここまでは, 電場と磁場を分けて考えてきたが, これ以降ではこれらが共存する場合を考える. 電磁波などはその最たる例である.

*2 $L_{ii} > 0$, $L_{ij} < L_{ii}, L_{jj}$ であり, L は正定値.

6.1 マクスウェルの応力

電場や磁場は物質に力を及ぼすが、これを応力の形にまとめて表すことができる。以下ではこれを議論しよう。電荷密度 $\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$ と電流密度 $\mathbf{j} = \nabla \times \mathbf{B} / \mu_0 - \epsilon_0 \dot{\mathbf{E}}$ を用いて、系に働く全力は

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \int d^3x (\rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}) = \int d^3x \left[\epsilon_0 \mathbf{E} \nabla \cdot \mathbf{E} + (\nabla \times \mathbf{B} / \mu_0) \times \mathbf{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B} \right] \\ &= \int d^3x \left[\epsilon_0 \mathbf{E} \nabla \cdot \mathbf{E} + (\nabla \times \mathbf{B} / \mu_0) \times \mathbf{B} + \epsilon_0 (\nabla \times \mathbf{E}) \times \mathbf{E} - \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E} \times \mathbf{B}}{\partial t} \right], \end{aligned} \quad (114)$$

と変形できる。 $\mu_0^{-1} \mathbf{B} \nabla \cdot \mathbf{B} = \mathbf{0}$ を付け足して式を対称な形に表すと

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \epsilon_0 \int d^3x [\mathbf{E} \nabla \cdot \mathbf{E} + (\nabla \times \mathbf{E}) \times \mathbf{E}] + \mu_0^{-1} \int d^3x [\mathbf{B} \nabla \cdot \mathbf{B} + (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}] \\ &\quad - \int d^3x \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E} \times \mathbf{B}}{\partial t}, \end{aligned} \quad (115)$$

となる。末項は電磁波による力である。第一項と第二項はそれぞれ、電場、磁場により生じる力である。これらをガウスの定理により、表面積分に書き換えることができる。

$$[\mathbf{E} \nabla \times \mathbf{E} + (\nabla \times \mathbf{E}) \times \mathbf{E}]_i = \partial_j \left[E_i E_j - \delta_{ij} \frac{E^2}{2} \right], \quad (116)$$

であり、また、磁場に対しても同じ式が成り立ち、

$$F_i = \int d^3x \partial_j T_{ji} = \int dS_j T_{ji}, \quad (117)$$

がガウスの定理から得られる。形から、 T_{ij} は応力テンソルの意味をもつ。ここで、

$$T_{ij} = \epsilon_0 \left[E_i E_j - \delta_{ij} \frac{E^2}{2} \right] + \frac{1}{\mu_0} \left[B_i B_j - \delta_{ij} \frac{B^2}{2} \right], \quad (118)$$

がマクスウェルの応力テンソルと呼ばれる量である。

6.2 電磁波

マクスウェル方程式

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0, \quad (119)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (120)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (121)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (122)$$

を四元ポテンシャル^{*3}

$$(A^\mu) = (\phi/c, \mathbf{A}), \quad (127)$$

$$\mathbf{E} = -\dot{\mathbf{A}} - \nabla\phi, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (128)$$

により書き換えると、波動方程式

$$\square A^\mu = \mu_0 j^\mu, \quad (129)$$

を得ることができる。□ = $\partial_\mu \partial^\mu = \partial_t^2/c^2 - \Delta$ はダランベルシアンと呼ばれる。ただし、ポテンシャルはローレンツゲージ

$$\partial_\mu A^\mu = 0, \quad (130)$$

が選ばれている。

^{*3} 四元ベクトルについて：

$$(x^\mu) = (ct, \mathbf{x}), \quad (\partial_\mu) = (\partial_t/c, \nabla), \quad (k_\mu) = (-\omega/c, \mathbf{k}), \quad (123)$$

$$(j^\mu) = (c\rho, \mathbf{j}), \quad (124)$$

$$(\eta_{\mu\nu}) = (\eta^{\mu\nu}) = \text{diag}(1, -1, -1, -1), \quad (125)$$

$$V_\mu = \eta_{\mu\nu} V^\nu, \quad V^\mu = \eta^{\mu\nu} V_\nu, \quad (126)$$

6.2.1 物質が無い場合（真空）

まずは物質が無い真空 $j^\mu = 0$ の場合を考察する．さらに，クーロンゲージ $\phi = 0$ ， $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ を選ぶと簡単である．その一般解は分散関係 $\omega_k = ck$ を用いて

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \left[e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_k t)} \mathbf{A}_{\mathbf{k}}^+ + e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \omega_k t)} \mathbf{A}_{\mathbf{k}}^- \right], \quad (131)$$

である．展開係数 $\mathbf{A}_{\mathbf{k}}^\pm$ は初期・境界条件により決まる．ただしくーロン条件から $\mathbf{k} \cdot \mathbf{A}_{\mathbf{k}}^\pm = 0$ でなければならない．ベクトルポテンシャルから電場と磁場が

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\dot{\mathbf{A}} = \text{Re} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \left[e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_k t)} (i\omega_k) \mathbf{A}_{\mathbf{k}}^+ + e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \omega_k t)} (-i\omega_k) \mathbf{A}_{\mathbf{k}}^- \right], \quad (132)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \nabla \times \mathbf{A} = \text{Re} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \left[e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_k t)} (i\mathbf{k}) \times \mathbf{A}_{\mathbf{k}}^+ + e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \omega_k t)} (i\mathbf{k}) \times \mathbf{A}_{\mathbf{k}}^- \right], \quad (133)$$

と表せる． $\omega_k > 0$ であるから，第一項は \mathbf{k} 方向に進行する波，第二項は $-\mathbf{k}$ 方向に進行する波，と解釈できる．

以下では単色の進行波

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} \left[e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_k t)} \mathbf{E}_{\mathbf{k}} \right], \quad (134)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} \left[e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_k t)} \frac{\mathbf{k}}{\omega_k} \times \mathbf{E}_{\mathbf{k}} \right], \quad (135)$$

を考える．明らかに， $\mathbf{B} = \mathbf{k} \times \mathbf{E}/\omega_k$ であり，電場と磁場は直交している．そのエネルギー密度 $u = \epsilon_0 E^2/2 + B^2/(2\mu_0)$ とポインティングベクトル $\mathbf{S} = \mu_0^{-1} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ は

$$u(\mathbf{r}, t) = \frac{\epsilon_0}{2} \text{Re} \left[e^{2i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_k t)} E_{\mathbf{k}}^2 \right] + \frac{\epsilon_0}{2} \mathbf{E}_{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E}_{\mathbf{k}}^*, \quad (136)$$

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \text{Re} \left[e^{2i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_k t)} E_{\mathbf{k}}^2 \frac{\mathbf{k}}{k} \right] + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \mathbf{E}_{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E}_{\mathbf{k}}^* \frac{\mathbf{k}}{k}, \quad (137)$$

と与えられる．ポインティングベクトルは \mathbf{k} に平行である．エネルギー密度，ポインティングベクトルともに，その時間平均は第二項のみで与えられることに注意する．

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T \frac{dt}{T} u(\mathbf{r}, t) = \frac{\epsilon_0}{2} \mathbf{E}_{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E}_{\mathbf{k}}^*, \quad (138)$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T \frac{dt}{T} \mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \mathbf{E}_{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E}_{\mathbf{k}}^* \frac{\mathbf{k}}{k}. \quad (139)$$

6.2.2 物質がある場合

次に物質がある場合 $j^\mu \neq 0$ を考える。ローレンツゲージにおけるマクスウェル方程式

$$\square A^\mu = \mu_0 j^\mu, \quad \partial_\mu A^\mu = 0, \quad (140)$$

は非斉次の微分方程式であり、その一般解は

$$A^\mu(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3x' \frac{j^\mu(\mathbf{r}', t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + A_0^\mu(\mathbf{r}, t), \quad (141)$$

の形に書ける。 A_0^μ は斉次解 $\square A_0^\mu = 0$ である。上式第一項は \mathbf{r}' から \mathbf{r} への影響が瞬時にではなく、光速 c で伝達してくる、という効果を表しており、遅延ポテンシャルと呼ばれている。

遅延ポテンシャルの導出を以下で行う。特解 A_s を求めるにはそのグリーン関数 G ;

$$\square G(\mathbf{r}, t) = \delta^3(\mathbf{r})\delta(t), \quad (142)$$

を求めて、

$$A_s^\mu(\mathbf{r}, t) = \int d^3r' dt' G(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') j^\mu(\mathbf{r}', t'), \quad (143)$$

と畳み込めば良い。グリーン関数を求めるには、まず、 G を時間に関してフーリエ展開する。

$$G(\mathbf{r}, t) = \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega t} G_\omega(\mathbf{r}), \quad (144)$$

微分方程式は

$$\left(-\frac{\omega^2}{c^2} - \Delta \right) G_\omega(\mathbf{r}) = \delta^3(\mathbf{r}). \quad (145)$$

原点が特異点であるから、球座標を採るのが便利である。また、解は球対称であるから $r \neq 0$ として、

$$\left[-\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) \right] G_\omega(\mathbf{r}) = 0, \quad (146)$$

として良い。さらに、 $G_\omega(\mathbf{r}) = \chi(r)/r$ とおくと、

$$\left(-\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\partial^2}{\partial r^2} \right) \chi(r) = 0, \quad (147)$$

という一次元の波動方程式に帰着される。その一般解は

$$\chi(\mathbf{r}, t) = \chi_+ \exp\left(i\frac{\omega}{c}r\right) + \chi_- \exp\left(-i\frac{\omega}{c}r\right), \quad (148)$$

の形をもつ。第一項は外向き，第二項は内向きの球面波に相当する。非斉次微分方程式の特解は一つだけ求めれば十分であるから，ここでは前者を選択し， $G_+(\mathbf{r}, t) = \chi_+ \exp(i\omega r/c)/r$ とする。 χ_+ は $r \rightarrow 0$ での振る舞いから決まる。 $r \rightarrow 0$ では $\omega^2 G \ll c^2 \Delta G$ であることに注意すると，

$$-\Delta \frac{\chi_+}{r} = \delta^3(\mathbf{r}), \quad (149)$$

を満たすように χ_+ が決まる。クーロンの法則

$$\Delta\phi(\mathbf{r}) = -q\delta^3(\mathbf{r}), \quad \phi(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3r'}{4\pi} \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (150)$$

を思い起こすと， $\chi_+ = 1/(4\pi)$ であることが分かる。したがって，遅延グリーン関数は

$$G_+(\mathbf{r}, t) = \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega t} \frac{e^{i\omega r/c}}{4\pi r} = \frac{\delta(t - r/c)}{4\pi r}, \quad (151)$$

であり，求めるべき特解は

$$\begin{aligned} A_s^\mu(\mathbf{r}, t) &= \int \frac{d^3r'}{4\pi} dt' \frac{\delta(t - t' - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} j^\mu(\mathbf{r}', t') \\ &= \int \frac{d^3r'}{4\pi} \frac{j^\mu(\mathbf{r}', t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \end{aligned} \quad (152)$$

となる。

6.2.3 運動する電荷のつくる場

以上を元に，運動する電荷 q がつくる電場と磁場を求める。粒子の軌跡を $\mathbf{x}(t)$ とすると，電荷密度 ρ および電流密度 \mathbf{j} はデルタ関数を用いて

$$\rho(\mathbf{r}, t) = q\delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{x}(t)), \quad (153)$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = q\dot{\mathbf{x}}(t)\delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{x}(t)), \quad (154)$$

と表現できる。遅延ポテンシャルは

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \int \frac{d^3r'}{4\pi} \frac{q\delta^3(\mathbf{r}' - \mathbf{x}(t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c))}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (155)$$

である。デルタ関数は \mathbf{x} に依存しており、簡単ではない。時間に関するデルタ関数を挿入して、3次元のデルタ関数の代わりに1次元のデルタ関数にすると簡単になる。

$$\begin{aligned}\phi(\mathbf{r}, t) &= \int \frac{d^3 r'}{4\pi} dt' \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta^3(\mathbf{r}' - \mathbf{x}(t')) \delta\left(t' - \left(t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right)\right) \\ &= \int dt' \frac{1}{4\pi} \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}(t')|} \delta\left(t' - \left(t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{x}(t')|}{c}\right)\right).\end{aligned}\quad (156)$$

ここで、デルタ関数に関する公式

$$\delta(f(x)) = \sum_{\alpha} \left| \frac{\partial f(x_{\alpha})}{\partial x_{\alpha}} \right|^{-1} \delta(x - x_{\alpha}), \quad f(x_{\alpha}) = 0, \quad (157)$$

を用いる。

$$\frac{\partial}{\partial t'} \left[t' - \left(t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{x}(t')|}{c} \right) \right] = 1 - \frac{\dot{\mathbf{x}}(t') \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{x}(t'))}{c|\mathbf{r} - \mathbf{x}(t')|} = 1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}, \quad (158)$$

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}|}, \quad \boldsymbol{\beta} = \frac{\dot{\mathbf{x}}}{c} \quad (159)$$

より、

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}(t_+)|} \frac{1}{1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}}, \quad (160)$$

である。 t_+ は遅延時間と呼ばれる (\mathbf{r}, t) の関数で

$$t_+(\mathbf{r}, t) = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{x}(t_+(\mathbf{r}, t))|}{c}, \quad (161)$$

という方程式の解である。ベクトルポテンシャルも同様であり、

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\dot{\mathbf{x}}(t_+)}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}(t_+)|} \frac{1}{1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}}. \quad (162)$$

これらの解はリエナール・ヴィーヘルトのポテンシャルと呼ばれている。遅延効果は $\boldsymbol{\beta} = \dot{\mathbf{x}}/c$ に比例する。

場の計算では以下の微分が必要になる。

$$\frac{\partial t_{\alpha}}{\partial t} = 1 + \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta} \frac{\partial t_{\alpha}}{\partial t} = \frac{1}{1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}}, \quad (163)$$

$$\begin{aligned}\nabla t_\alpha &= -\nabla \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{x}(t_\alpha)|}{c} = -\frac{1}{c} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}|} + \frac{\dot{\mathbf{x}}}{c} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}|} \nabla t_\alpha \\ &= -\frac{1}{c} \frac{\mathbf{n}}{1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}}.\end{aligned}\quad (164)$$

$$\nabla |\mathbf{r} - \mathbf{x}| = \frac{\mathbf{n}}{1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}}, \quad (165)$$

$$\nabla \left[\frac{\dot{\mathbf{x}}}{c} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{x}) \right] = \boldsymbol{\beta} + \frac{\beta^2 - (\mathbf{r} - \mathbf{x}) \cdot \ddot{\mathbf{x}}/c^2}{1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}} \mathbf{n} \quad (166)$$

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial t} = \frac{\partial t_\alpha}{\partial t} \dot{\mathbf{x}}, \quad \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}}{\partial t} = \frac{\partial t_\alpha}{\partial t} \ddot{\mathbf{x}}, \quad (167)$$

$$\frac{\partial |\mathbf{r} - \mathbf{x}|}{c \partial t} = -\frac{\partial t_\alpha}{\partial t} \boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{n} = -\frac{\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}}{1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}}, \quad (168)$$

$$\frac{\partial}{c \partial t} \left[(\mathbf{r} - \mathbf{x}) \cdot \frac{\dot{\mathbf{x}}}{c} \right] = -\frac{\partial t_\alpha}{\partial t} \beta^2 + \frac{\partial t_\alpha}{\partial t} (\mathbf{r} - \mathbf{x}) \cdot \frac{\ddot{\mathbf{x}}}{c^2} = \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{x}) \cdot \ddot{\mathbf{x}}/c^2 - \beta^2}{1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}}, \quad (169)$$

これらを用いて面倒な計算を行うと、

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= -\nabla \phi(\mathbf{r}, t) - \dot{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}|^2} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta})^3} (\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}|} \frac{\mathbf{n} \times (\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \ddot{\mathbf{x}}/c^2}{(1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta})^3}.\end{aligned}\quad (170)$$

を得る。第一項は、静電場に遅延効果を取り入れたものになっており、距離の二乗で減衰する。一方、第二項は加速度に比例しており、距離の一乗で減衰（長距離まで伝搬）する。これは電磁波放射に対応する。また、磁場は電場と直交し

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{n} \times \mathbf{E}}{c}, \quad (171)$$

で与えられる。

$\boldsymbol{\beta} \rightarrow \mathbf{0}$ の極限を考えると、 $t_+ = t$ であり、

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}(t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}(t)|^3} + \mathcal{O}(\boldsymbol{\beta}), \quad (172)$$

となる。これは、 $\mathbf{x}(t)$ にある点電荷がつくる電場である。すなわち、ポテンシャルは瞬時に伝搬するとみなせる。

参考文献

- [1] ランダウ＝リフシッツ「場の古典論」東京図書.
- [2] <http://busseiqanda.la.cocan.jp/electrod.pdf>